



三洋半導体
ニュース

No 1401
8043

2SC3486

シリコン NPN 高集積度アレーナ型トランジスタ

高精細度CRTディスプレイ水平偏向出力用

- 特長
- ・高耐圧、高信頼性である。
 - ・スイッチングスピードが速い： $t_f=0.3\mu s \text{ max.}$
 - ・一点止め樹脂モールドパッケージで 取り付け作業性が良い。

絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/ $T_a=25^\circ C$

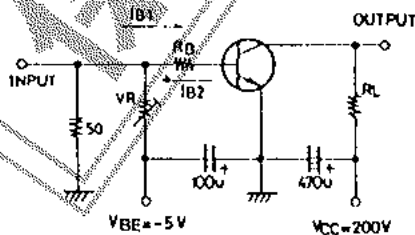
			unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	1500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	800	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	7	V
コレクタ電流	I_C	6	A
ピークコレクタ電流	i_{cP}	16	A
コレクタ損失	P_C	120	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ C$
保存周囲温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ C$

電気的特性 Electrical Characteristics/ $T_a=25^\circ C$

			min	typ	max	unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=800V, I_E=0$			10	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5V, I_C=0$			1	mA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=5V, I_C=1A$	8			
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=10V, I_C=1A$		3		MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=5A, I_B=1.2A$			5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=5A, I_B=1.2A$			1.5	V
コレクタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)CB0}$	$I_C=5mA, I_E=0$	1500			V
コレクタ・エミッタ降伏電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_C=5mA, R_{BE}=\infty$	800			V
エミッタ・ベース降伏電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E=5mA, I_C=0$	7			V
蓄積時間	t_{stg}	$I_C=5A, I_B1=1A,$			3.0	μs
下降時間	t_f	$I_B2=-2A,$ $R_L=40\Omega$			0.3	μs

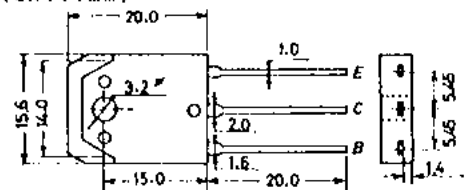
スイッチングタイム測定回路

$PW=20\mu s, \text{Duty}\leq 1\%$



外形図 2022

(unit: mm)



E: Emitter
C: Collector
B: Base

＊これらの仕様は、改良などのため変更することがあります。

〒370 05 群馬県大泉町坂田180

東京三洋電機(株)半導体事業部

TEL. 0276 63 2111 (大代表)

This datasheet has been download from:

www.datasheetcatalog.com

Datasheets for electronics components.